PHOTOELECTROCHEMICAL BATTERY AND ITS MANUFACTURE

Patent number:

JP1220380

Publication date:

1989-09-04

Inventor:

MIKAERU GUREETSUERU; POORU RISUKA

Applicant:

SULZER AG

Classification:

- international:

(IPC1-7): H01L31/04; H01M14/00

- european:

H01G9/20D2

Application number: Priority number(s):

JP19880090153 19880412

CH19880000505 19880212

Also published as:

EP0333641 (A1) US5084365 (A1)

US4927721 (A1)

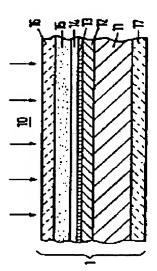
CH674596 (A5)

EP0333641 (B1)

Report a data error here

Abstract of JP1220380

PURPOSE: To enhance the yield of electric energy by having a polycrystalline metal oxide semiconductor formed on a regenerative photoelectrochemical cell and making the semiconductor have a surface roughness coefficient greater than a specific value. CONSTITUTION: A regenerative photoelectrochemical cell 1 has a polycrystalline metal oxide semiconductor layer 12 applied to the top of a metal support 11. Further a monomolecular layer 13 of a sensitize of coupler is provided adjacent to an electrolyte layer 14 on the layer 12. The layer 12 is formed to show a coefficient of surface roughness greater than 20, preferably greater than 150. The rough surface with a polycrystalline structure can provide a greater plane by the coefficient of surface roughness because of the monomolecular surface layer of the coupler. Therefore, light incident on a plane of a certain dimension can be converted into electric energy in significantly high yields.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

⑩ 日本 国特 許 庁 (IP)

① 特許出題公開

◎ 公開特許公報(A) 平1-220380

®Int. Cl. ⁴

識別記号

庁内整理番号

個公開 平成1年(1989)9月4日

H 01 M 14/00 H 01 L 31/04 P-6728-5H Z-6851-5F

審査請求 未請求 請求項の数 12 (全6頁)

公発明の名称 光電化学電池とその製造方法

@特 願 昭63-90153

②出 願 昭63(1988) 4月12日

特許法第30条第1項適用 1987年10月14日に発行された「サーフェス サイエンス, 189/190巻 (1987) 823-831」において発表

優先権主張 Ø1988年2月12日 Øスイス(CH) ®00505/88-3

@発 明 者 ミカエル グレーツエ ル

スイス国サン スルピセ, シュマン ドュ マルキサット

77-

@発明者 ポール リスカ

スイス国ローザンヌ, シユマン デ ポツソン 47

⑦出 顋 人 ゲブリユーダー ズル

スイス国ウインターツール, ツルヘルストラーセ 9

ツアー アクチエンゲ

ゼルシヤフト

砂代 理 人 弁理士 浅 村 皓 外2名

明 柳 杏

1. 発明の名称

光電化学電池とその製造方法

- 2. 特許請求の範囲
 - (1) 多結晶の金属酸化物半導体(12)を有し、かつその表面域に広範囲にわたり単分子発色剤扇(13)を有する再生型光電化学電池(1)であって、前記金属限化物半導体(12)が、20より大きな、好ましくは150より大きな表面組さ像数を示すことを特徴とする前記の光電化学電池(1)。
 - (2) 金 は 酸 化 物 半 導体 (1 2) が 遷 移 金 既 の 、 また は 第 5 また は 第 6 重 旅 の 元 来 の 、 符 に ま タン 、 ジルコニウム 、 ハフニウム 、 ストロンチウム 、 延 却 、 イン ラウム 、 イット リウム 、 ランタ ル 、 タンタル 、 の と ロンター 、 の な の で に い な に い な に い な に い な に い な に い な に い な に い な に い な に い な に い な に い な に い な に い な に い な に い な に い な に い な に い た に な ほ の こ れ ら の で に い な に い た に い た に な ほ の こ れ ら の べ ロ ブ ス カ ィ ト 、 お よ び / ま た は 数 種 の こ れ ら

の金属の複合酸化物および/または酸化物混合物であることを特徴とする、特許額求の範囲第1項に記載の光能化学電池(1)。

- (3) 発色常額(13)が選移金銭結体より形成されることを特徴とする、特許請求の範囲第1項または第2項に記載の光電化学電池(1)。
- (4) 発色剤(13)が、ルテニウムートリス (Rula)、ルテニウムービス(Rula)、オスニウムートリス(OSI、3)、オスニウムーヒス(OSI、2)型の選移金銭額体、または Rula (H2 O)2型のルテニウムーシスークアーピピリシル鏡体、例えば、ルテニウムーシスージアクアーピス(2.2′ーピピリシルー4、4′ージルカボキシラート)であることを特徴とする、特許請求の範囲第3項に記収の光徹化学電池(1)。
- (5) 発色剤器(13)が金属または非金属のフタロシアニンまたはボルフィリンであることを特徴とする、特許請求範囲第1項または第2項に配載の光電化学電池(1)。

- (6) 現色剤(13)の配位子がカルボン酸配位子であることを特徴とする、特許額求の範囲第1 項より第5項までのいずれかに記載の光甜化学館 池(1)。
- (7) 再生的に迅価輸送にあずかつている電解質(14)がヨウ化物、臭化物、ヒドロキノンまたはそれらの数理を含むことを特徴とする、特許額求の範囲第1項より第6項までのいずれかに記収の光電化学電池(1)。
- (8) 金属アルコラートの加水分解工程において雰囲気の百分率相対程度が30%より80%までの範囲にある、特許請求の範囲第1項より第7項までのいずれかに記載の光電化学電池(1)のための多結品金属酸化物半導体阻(12)をゾルーグル法により製造する方法。
- (9) 金瓜アルコラートの加水分解工程において 雰囲気の百分率相対程度が±5%以内に、好ましくは少なくとも±1%以内に一定に保たれる、特許許求の範囲新1項より第8項までのいずれかに記載の光電化学電池(1)のための多格品金属設

化物半導体層(12)をゾル・ゲル法により製造する方法。

- (10) 雰囲気の得成が48%±2%、好ましくは48%±1%、の範囲内に一定に保たれる、特許 設まの範囲第9項に記載の光電化学電池(1)のための酸化チタン(TiO₂)の多枯晶別(12)を製造する方法。
- (11) 光(10)から電気エネルギーを発生させるための、特許請求の範囲第1項より第7項までのいずれかに記載の光電化学電池(1)の、および/または特許請求の範囲第8項より第10項までのいずれかに記載の方法により調整された、光電池(1)内の多結基半導体間(12)の使用。(12) 太陽電池としての、特許請求範別第11項に記載の光電化学団池(1)の使用。

3. 発明の詳細な説明

本発明は、多結晶の金属酸化物半導体を有し、 かつその表面域に広範囲にわたり単分子発色剤圏 を有する再生型光電化学電池、その種の電池のた めの多結晶金属酸化物半導体を製造する方法およ

びそれらの電池の使用に関する。

半海体/世界質の界面が、半導体/金属の界面のショットキー形向壁に類似の光電化学特性を示すことは知られている。半導体自身の電荷キャリャーがそこで光により縁起される、エネルギー帯と領電子帯の間の僅かの間障を有する半導体(例えば、ケイ素、ヒ化ガリウム、硬化カドミウム)は光照射の下で使用の際に電解質により光度食的に分解される。

安定な金属酸化物半導体を有する再生型光電化学能能は光、特に日光による照射の際に悪い収量を示す。それは衝電子帯と伝導帯の間の空感が比較的大きいからである(3eV・400mm 入)。光吸収は金属酸化物半導体において紫色部と紫外部の光に別段されている。この金属酸化物半導体は広範に光透過性であるが、光照射の際に電解質を使用しても化学的に安定でありかつ低抗性があった。

可視光に対する、したがつてまた日光に対する 風度、すなわち光電化学収量は、半導体の表面に

Compared to the second

いわゆる発色剤(また増級剤あるいは染料とも呼ばれる)を指荷キャリヤーとして化学的に付加または沈若(化学吸替)させることにより向上させることができる。光吸収と電荷キャリヤー分配の高機能はこれらの光量化学系において区別される。光吸収は装面域内の発色剤により引き受けられ、そして電荷キャリヤーの分離は半導体/発色剤の境界器において行われる。

しかしまた平滑な表面を有する金属酸化物半導体のこの磁の電気化学系においては吸収スペクトルの極大における収量(入射する光量子エネルギーの百分率での発生電気エネルギー)は通常を少数パーセントの範囲(例えば、O. 1%~O. 2%の範囲)にあるに過ぎない。

本発明の課題は、その多結晶金融酸化物半導体が腐食せずかつ光スペクトル、特に日光のスペクトルの領域で改良された電気エネルギー収量を示す、長待ちする再生型光電化学電池を造ることである。本発明の他の一つの課題は、この後の光電化学電池のための金属酸化物半導体の製造方法を

よる光気化学電池の使用もしくは本発明の方法に 従って製造された電池の使用に関する。

本発明によるものは、金属融化物半導体が20 より大きな、好ましくは150より大きな表面担 さ係数を示すことを特徴とするような再生型光電 化学発泡である。表面取さ係数は、ある物体のこ の表面の、われわれの場合には金属産化物半導体 の光電化学的に低性な裏面の、射影平面に対する 実際の/有効な表面の比率として定義される。従 與する特許請求の範囲第2~6項は、光電化学電 他の特に有利な突旋燃煤および突旋燃煤の群に関 ta.

ゾル-ゲル法(例えば、Stalder and Augustynski , J. Electrochem. Soc. 1979, 126、2007に詳細に記載されている〉によ る多結局金属機化物半導体間の製造方法では、金 **区アルコラートの加水分解工程において雰囲気の** 百分串相対稳度が30%から80%までの範囲に あることができ、かつ±5%以内に、好ましくは

いろいろな発色対が異なつたスペクトル感度を 有する。発色剤の遺訳は従つて収量をできるだけ 大きくするように光額の光のスペクトル構造に遊 あしてなすことができる。

・金風酸化物半導体として特に近移金属の機化物、 **財えば、(元素の周期表の)第3主族と第4、第** 5 および第6 亜族の元素、すなわちチタン、グル コニウム、ハフフニウム、ストロンチウム、亜鉛、 インタウム、イツトリウム、ランタン、パナタウ ム、ニオブ、タンタル、クロム、モリプデン、タ ングステンの酸化物、なおまた亜鉛、株、ニッケ ルまたは銀の酸化物、SrTIO。、

CaTIO。のようなペロプスカイト、または第 2 および第3 主族の他の金属の悪化物、あるいは これらの金銭の複合融化物または融化物器合物、 が適当である。しかしまた半導体特性および領電 子帯と伝媒帯との間に大きなエネルギー問題(称 空隙)を有する他の名伝導性金属機化物も使用す ることができる。

発色剤、すなわち増感剤、として適当なものは、

同葉することである。木苑朋はさらに、本苑朋に ・・ ± 1%以内に一定に保たれるが、それにより本苑 明に従う光世化学句池において特に高い田気化学 的収益が得られる金風酸化物半導体膜を生する。 特に48%の領域の相対温度において製造される ような酸化チタン酉により12%の単色効率を貸 ることができる。その効率は入引する光エネルギ 一の百分率において最高点の速点を意味する。

> 多結晶構造を存する粗い表面は、発色剤の単分。 子表面質のために表面和さ係数だけ、より大きな 面を提供する。それにより一定の大きさの頃に入 射する光を着しく高い収量で電気エネルギーに変 換することが違成される。金属股化物半導体は入 ・射光線に対して透過性と見なすことができる。し かし光は装飾上で一部反射され、また一部分は関 接する層に到達する。金鳳酸化物学導体内に侵入 する光および単分子発色剤瘤によつて吸収されず かつ変換されない光は一部直接にそして他の一部 は間接に、装面上で全反射の後に出口側で発色剤 分子に当り、それにより若しく高い光収量を得る ことに成功する。

例えば、ルテニウムとオスミウムの金属(L3)、 金属(しう)型の遊移金皿結体(例えば、ルテニ ウムートリス(2、2′ーピスピリクルー4、 4′ージカルボキシラート)、ルテニウムーシス ーラアクアーピピリジル錯休、例えば、ルテニウ ムーシスークアクアービス(2.21 - ビビリジ ルー4.4′ ー フカルボキシラート)、ならびに ポルウィリン(例えば、亜鉛-テドラ(4-カル ポキシフエニル) ポルフイン)、およびシアニド (例えば、鉄ーヘキサシアニド媒体)、そしてフ タロシアニンである。

発色剤は限化物半導体の表面域に化学吸着され るか、単に吸着されるか、さもなくは固く堆積さ れていることができる。好ましい結果は、例えば、 エステル配位子の代りにカルボン放配位子により 金属農化物学導体の表面に結合されている発色剤 により得られた。

このような光電化学電池用の電解費として適当 なものはヨウ化物、臭化物またはヒドロキノンも しくはその他のレドツクス系である。これらの包

界質はその酸化速元電位に基づいて電荷輸送のための純点たる中離物質の役をつとめる。例えば、1mHのHCLO4を含むそのようなレドツクス系の10-2M溶液は電荷輸送を促進する電解質として適当である。

チタン試材上に高い表面狙さ係数を有する酸化 チタン型(TiO₂)を造る例に基づいて次にゾル・ゲル法を説明する。

第2回は、大きな表面和さ係数を有する金属酸化物半導体器212を、その表面域に配列された発色剤分子213の単分子器と共に軽固に強く拡大して示している。この単分子別は吸管された、化学吸着された発色剤分子213から成ることができる。金属酸化物半導体の中へ初めにまた原子

する。この工程を改回線返す。10~15回反復の後、Ti02 層は約20μの厚さに達した。それからその概を有する基材を約500℃において約30分間準アルゴン雰囲気(例えば、

99.997%)の中で加熱する。かくして翻製されたTi〇2 層は200の領域に表面割さ係数を有する。このような金銭酸化物半導体器(他の金属のものも)は他の基材の上に類似の方法によって開製されることができる。

発色剤(例えば、RuL3⁴⁻)の連布は酸化物 概を有する話材を2×10⁻⁴M RuL3⁴⁻ 水溶 被(約3.5の計値を示す)の中に約1時間没演 することにより行われる(pH値は希釈された HCょに適応する)。他の発色剤も類似の方法に より酸化チタンまたはその他の金属酸化物半導体 の上に速布される。

本発明についてその他の詳細は図面から明らかになる。第1図に描かれた光體池1の断面は、一定の額尺によらないが、金属担体11を示し、その担体上に例えば脱化チタンから成る金属脱化物

または分子がドーピングされて、そしてその回り に発色剤分子が配列されることもあり得る。

第3回は、金鳳融化物半導体としてTIO2を そして発色剤としてRuL₃4 を有する光電化学 危他の光電的に発生された電流を入射光束に関し て百分串で、いろいろな故長につきまたいろいろ な電解質について描いた2種の韓因を示す。複雑 に光電視効率が百分率で、機能に入射光の放長が nmで表されている。ペース世解賞としては H C L O 4 水溶液(1 O ⁻³M (モルの))が俎子 供与体として使用された。曲線3.1に基づく一選 の選定においては、Rula⁴⁻ により被獄した Ti0。と、追加の世解質として1MのKIが使 用された。曲線32の一選の測定においては、 Rul $_3$ 4- により被駆したTIO,と、追加の電 解質として0.1MのNaBrが使用された。比 姓のため曲線33の一連の測定は発色剤を含まな いTi0,において示され、そして追加の電解質 として104Mのヒドロキノンが使用された。

新 4 図は 最後に、光 勝 植 と し て R u L ₃ ^{4 --} で 被

被覆されたTiO₂の金属酸化物半導体と白金の 反対電極を有する再生型光電化学電池の光電波ー 電圧曲線40 (特性曲線)を示す。 既領上に 歌地 の電流がミリアンペアで、また機能に電圧がポル トで表されている。 知恵の面積は4 cm2 である。 電池の上に入別する光は1.58W/m²の比表 面出力を有する。それ故この電池はO. 832 m¥ の光によって風引される。 超解質は10⁻³M HCIO, IM LIBERSTUTO 3M Br,を含有する。電視を生じさせる光の被長は 4 6 0 nmである。いわゆる占額率 4 1 (2 本の組 いねの辺で囲まれた長方形の両板により表わされ ている)は0.74になり、そして単結晶ケイ素 による電池の領域内にある。(観池の占積率=最 大出力/(短格電流×回路電圧))。この電池の 単色光の効率のは12%であり、(及音点におけ る出力×100)/(入射光エネルギー)として 定位される。

4. 図面の簡単な説明

第1回は、本発明の金属酸化物半導体層を有し、

4 1 … 占稿本

代理人 挨 村 略

かつその最の表面が発色剤で被覆されている、光 電化学電池の構造を略図で示す。

第2回は、発色剤甲分子原を有する金段酸化物 半導体の断面を略図で示す。

第3回は、発色剤としてRUL3⁴を有する歴化チタンについて、およびいろいろの選解質を使用した際の光の設長に依存する光電気を入射光束の百分率で扱わしている。

第4回は、RUL3⁴で被覆された酸化チタンを有する光電化学電池の、波長470mmの入射光に対する光電波一截圧特性曲線を示す。

1 -- 光電池

10…光

11…金凤姐体

. 12…金属酸化物半導体器

13一発色游標

1 4 -- 電解質問

15…世版

16… 格段图

17… 絶経順

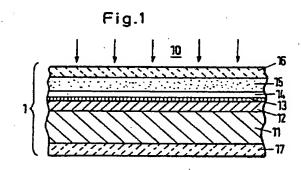
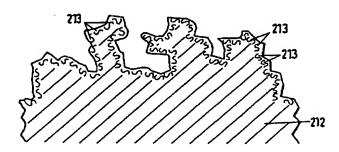
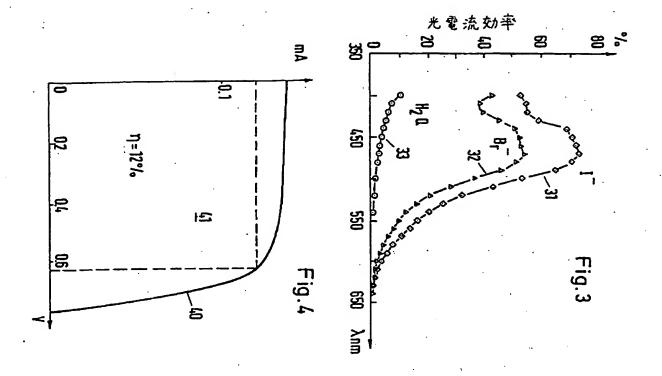


Fig.2





This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.